

附件 5

“战略性先进电子材料”重点专项 2020 年度项目申报指南

为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》和《中国制造 2025》等提出的任务，国家重点研发计划启动实施“战略性先进电子材料”重点专项。根据本重点专项实施方案的部署，现发布 2020 年度项目申报指南。

本重点专项总体目标是：面向国家在节能环保、智能制造、新一代信息技术领域对战略性先进电子材料的迫切需求，支撑“中国制造 2025”“互联网+”等国家重大战略目标，瞄准全球技术和产业制高点，抓住我国“换道超车”的历史性发展机遇，以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心，以大功率激光材料与器件、高端光电子与微电子材料为重点，通过体制机制创新、跨界技术整合，构建基础研究及前沿技术、重大共性关键技术、典型应用示范的全创新链，并进行一体化组织实施。培养一批创新创业团队，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，形成各具特色的产业基地。

2020 年重点专项拟启动 8 个公开择优重点研究任务，拟安排国拨经费总概算为 3900 万元。企业牵头申报的项目，其他经费（包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等）与中央财政经费

比例不低于 1:1。项目执行期为两年。每个项目下设课题数原则上不超过 3 个，参与单位总数不超过 5 家。每个研究任务拟支持项目数均为 1~2 项。申报项目的研究内容须涵盖该重点任务指南所列的全部考核指标。

指南中“拟支持项目数为 1~2 项”是指：在同一研究方向下，当出现申报项目评审结果前两位评价相近、技术路线明显不同的情况时，可同时支持这 2 个项目。2 个项目将采取分两个阶段支持的方式。第一阶段完成后将对 2 个项目执行情况进行评估，根据评估结果确定后续支持方式。

本专项 2020 年项目申报指南如下：

1. 封装基板材料在新能源汽车电驱模块上的应用(应用示范类)

研究内容：面向新能源汽车电驱模块高效热管理需求，设计高热导/低膨胀铝碳化硅散热基板结构，研究散热基板快速成型制备技术，开发适用于氮化硅陶瓷覆铜板的钎焊材料和活性钎焊（AMB）覆铜工艺，开展铝碳化硅散热基板和基于活性金属钎焊的氮化硅陶瓷覆铜板在新能源汽车上电机驱动封装模块的应用研究，开发铝碳化硅散热基板和基于活性金属钎焊的氮化硅陶瓷覆铜板的批量生产技术。

考核指标：高热导/低膨胀铝碳化硅基板材料热导率 $\geq 210\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，平均热膨胀系数 $\leq 7.5\times 10^{-6}/\text{C}$ 。138mm \times 190mm 氮化硅陶瓷活性金属钎焊覆铜板，铜层与氮化硅陶瓷层的剥离强度 10N/mm，孔洞率 $< 1\%$ ，翘曲率 $< 10\%$ ，-55 $^{\circ}\text{C}/150^{\circ}\text{C}/15\text{min}$ 热循

环 2000 次后，铜层不出现剥离。散热基板和覆铜板中试生产能力均大于 1 万片/年。运用此技术的功率器件可满足车规级 AEC-Q101 和 AQG324 等国际可靠性标准，以及通过整车厂的两个或以上新能源汽车平台的测试和验证。申请发明专利 4 项。

2. 功率碳化硅芯片和器件在移动储能装置中的应用（应用示范类）

研究内容：开发低比导通电阻高可靠 1200V 碳化硅 MOSFET 芯片的产业化技术，并对芯片产品的栅氧可靠性、单管器件产品的长期可靠性以及单管器件产品的雪崩、浪涌、短路等极端条件可靠性等进行测试表征，开展 1200V 碳化硅 MOSFET 器件在移动储能装置中的应用。

考核指标：1200V 碳化硅 MOSFET 芯片比导通电阻 $\leq 5\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ ，器件电阻 $\leq 80\text{m}\Omega$ ，器件可靠性满足移动及户用储能装置应用的相关要求，系统功率从 1kW~22kW，满载充放电效率 $> 96\%$ 的单相和三相装置。器件中试生产能力大于 10 万个/年，申请发明专利 2 项。

3. 在设施农业中紫外 LED 应用模组和系统技术应用（应用示范类）

研究内容：设计适用于设施农业高效生产与品质提升的紫外 LED 应用模组工作场景；开展模组结构设计、热场分布、结温调控、驱动电路设计以及老化与失效分析研究；研发高可靠性设施农业杀菌辐照模块；开发基于深紫外—紫外波段的植物工厂叶用

蔬菜采前营养品质调控辐射模组；研究紫外对种苗品质提升的光配方优化参数，开发用于全人工光育苗工厂的深紫外—紫外模组。

考核指标：开发出设施农业杀菌辐照模块，发光波长 280nm 以下，光功率密度 $0.5\text{W}/\text{cm}^2$ ，杀菌率 99.9%，寿命 5000 小时；构建叶用蔬菜品质提升的光配方，开发出植物工厂叶用蔬菜品质提升的深紫外—紫外辐射模组，提高 Vc15%、可溶性糖 20%、类黄酮、萜烯类等功能成分 15%~20%；制定紫外 LED 设施农业应用标准 1 项。

4. OLED 显示功能材料的批量合成和应用（应用示范类）

研究内容：对具有自主知识产权的空穴传输、电子传输和发光主体材料等的批量合成工艺、及在 OLED 显示屏中的应用性能进行研究。研究材料从粗品合成与提纯的批量放大工艺和杂质控制技术，建立绿色合成及提纯工艺，获得可批量制备的材料各 1~2 种；研究材料在显示屏生产中的成膜工艺和发光性能等，建立材料性能影响 OLED 器件品质的工艺评价方法，获得满足 OLED 显示性能的材料生产技术条件，完成在 G6 代 OLED 面板生产线上的应用验证；系统研究 OLED 显示材料体系，建立材料结构、性能和应用条件等数据库，为材料开发、应用和知识产权布局提供决策依据。

考核指标：空穴、电子传输和发光主体材料合成能力 $\geq 10\text{kg}/\text{批}$ 、单台单批提纯能力 $> 2\text{kg}$ ，纯度 $\geq 99.99\%$ ；空穴传输薄膜相态稳定温度 $> 120^\circ\text{C}$ 、失重率 $< 1\%$ （ 350°C 时），载流子迁移率

(@10mA/cm²): $\mu_h > 5.0 \times 10^{-4} \text{cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$, $\mu_e > 1.0 \times 10^{-5} \text{cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$, 电位稳定性能 < 0.2V (50nm 及 120nm 膜厚下器件电压变化)。主体材料稳定性: 持续蒸镀 (200hrs) 纯度 > 99.9%; 器件性能 (顶发光): 绿光 (15000cd/m² 下): 电压 < 4V, 效率 > 170cd/A, 寿命 LT97 > 1000 小时; 红光 (6000cd/m² 下), 电压 < 4V, 效率 > 70cd/A, 寿命 LT97 > 1000 小时。制定材料应用行业标准 1~2 项。

5. 柔性 OLED 显示基板用聚酰亚胺浆料材料应用研究(应用示范类)

研究内容: 研究柔性 OLED 显示基板用聚酰亚胺的单体、预聚体浆料的批量生产技术及其工艺稳定性, 对产品质量和性能的一致性进行验证; 研究在柔性 OLED 显示屏生产线上聚酰亚胺浆料的成膜工艺、耐热稳定性、尺寸稳定性和力学强度等特性, 实现批量流片应用; 建立聚酰亚胺浆料的成膜工艺及薄膜性能的评价方法, 开发国产基板材料在柔性 OLED 显示屏生产中的全工艺流程、并完成批量导入。

考核指标: 浆料固含量 > 15%, 大于 0.5 μm 的颗粒物杂质数 < 1/mL, 印刷孔洞数 < 1/cm² (直径小于 2 微米)。薄膜失重率 < 0.5% (500 $^{\circ}\text{C}$), 拉伸强度 > 180MPa, 弯曲半径 < 10mm, 柔性 AMOLED 样机屏 $\geq 7\text{inch}$ 。形成 1000 吨/年聚酰亚胺浆料的产能规模, 存储稳定性 > 6 个月; 在 G6 柔性 OLED 显示屏量产线上完成 200 张/批流片应用, 满足柔性 AMOLED 量产的良率和显示的性能要求; 制定聚酰亚胺浆料的国家标准 1 项。

6. 高性能 Micro-LED 芯片与显示关键技术研究（应用示范类）

研究内容：研究 Micro-LED（微米级 LED）发光芯片的外延生长工艺技术，研究芯片在不同电流密度下的发光效率、波长一致性、均匀性、可靠性和寿命等影响规律，建立 Micro-LED 器件评价和测试体系；设计 Micro-LED 芯片与 CMOS 芯片微米级金属共晶键合微结构，研究金属共晶互联的混合集成技术；开发 Micro-LED 芯片与 CMOS 芯片的键合与集成技术，开发拥有自主知识产权的 Micro-LED 技术，实现高性能单色 Micro-LED 显示样机。

考核指标：Micro-LED 芯片：晶圆尺寸 ≥ 6 寸，蓝光 EQE $> 35\%$ ，绿光 EQE $> 25\%$ ，红光 EQE $> 10\%$ ；T50 达到 5000 小时 @2000cd/m²；Micro-LED 显示器件：对角线尺寸不大于 0.7inch，分辨率不小于 1920×1080，点间距 $\leq 8\mu\text{m}$ ，亮度 $\geq 5000\text{cd/m}^2$ ，灰度等级 ≥ 256 ，单色显示。申请发明专利 10 项。

7. 单频光纤激光器及相干探测技术应用（应用示范类）

研究内容：研究单频激光放大过程中偏振控制、谱线展宽、噪声抑制、频率稳定和宽带调谐等过程的稳定性关键技术和工艺，单频激光器主要技术指标的一致性关键技术和工艺，面向远距离探测的单频光纤激光脉冲调制放大及锁频发射技术，单频光纤激光相干探测系统高灵敏度信号接收、弱信号放大与处理、以及集成技术。实现单频光纤激光器在相干探测系统中批量应用。

考核指标：单频光纤激光器工作波长为近红外、输出功率 $> 100\text{W}$ 、线宽 $< 10\text{kHz}$ 、相对强度噪声 $< -120\text{dB/Hz}$ ，技术指标一致

性 > 95% @ 20 台；相干探测系统探测距离 $\geq 20\text{km}$ ，精度优于 $\pm 7\text{m}$ ；实现 50 台套以上的单频光纤激光器批量应用。申请发明专利 5 项。

8. 基于量子级联激光器的人体呼出气体检测技术应用研究（应用示范类）

研究内容：开发基于量子级联激光器（QCL）的碳 13（C13）测定系统，并应用于 C13-尿素呼气试验，实现对于人体胃部幽门螺旋杆菌的无损快速检测；结合肺癌呼出气组学筛查研究，通过大样本临床诊断试验、胸部 CT、病理诊断等临床技术手段比较做出敏感性、特异性、准确性和可靠性评价，验证 QCL 肺癌呼出气体检测临床应用效果，为肺癌筛查和诊断确立标志性呼吸气体。

考核指标：研制出基于 QCL 的 C 同位素检测系统样机，C13/C12 同位素比例检测精度优于 0.5‰，满足对幽门螺旋杆菌感染进行高敏、快速、无创伤检测需求；基于 QCL 建立样本量为 2000 例的呼出气体数据库，结合色谱、质谱技术等肺癌痕量呼出气筛查结果，利用红外 QCL，高敏、高精度验证 ppb 级别（十亿分之一）标志性气体成分不少于两种，整合数据库临床参数建立肺癌诊断判别模型。

“战略性先进电子材料”重点专项 2020 年度 项目申报指南形式审查条件要求

申报项目须符合以下形式审查条件要求。

1. 推荐程序和填写要求

(1) 由指南规定的推荐单位在规定时间内出具推荐函。

(2) 申报单位同一项目须通过单个推荐单位申报，不得多头申报和重复申报。

(3) 项目申报书（包括预申报书和正式申报书，下同）内容与申报的指南方向相符。

(4) 项目申报书及附件按格式要求填写完整。

2. 申报人应具备的资格条件

(1) 项目（课题）负责人应为 1960 年 1 月 1 日以后出生，具有高级职称或博士学位。

(2) 受聘于内地单位的外籍科学家及港、澳、台地区科学家可作为重点专项的项目（课题）负责人，全职受聘人员须由内地聘用单位提供全职聘用的有效材料，非全职受聘人员须由内地聘用单位和境外单位同时提供聘用的有效材料，并作为项目预申报材料一并提交。

(3) 项目（课题）负责人限申报 1 个项目（课题）；国家科技重大专项、国家重点研发计划重点专项、科技创新 2030—重大项

目的在研项目（含任务或课题）负责人不得牵头申报项目（课题）。国家重点研发计划重点专项、科技创新 2030—重大项目的在研项目负责人（不含任务或课题负责人）也不得参与申报项目（课题）。

（4）特邀咨评委委员不能申报项目（课题）；参与重点专项实施方案或本年度项目指南编制的专家，不能申报该重点专项项目（课题）。

（5）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。

（6）中央和地方各级国家机关的公务人员（包括行使科技计划管理职能的其他人员）不得申报项目（课题）。

3. 申报单位应具备的资格条件

（1）在中国大陆境内登记注册的科研院所、高等学校和企业等法人单位。国家机关不得作为申报单位进行申报。

（2）注册时间在 2019 年 3 月 31 日前。

（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。

4. 本重点专项指南规定的其他形式审查条件要求

项目下设课题数原则上不超过 3 个，参与单位总数不超过 5 家。

本专项形式审查责任人：杨斌

“战略性先进电子材料”重点专项 2020 年度 项目申报指南编制专家名单

序号	姓名	工作单位	职称职务
1	陈弘达	中科院半导体研究所	研究员
2	崔 平	中科院宁波材料技术与工程研究所	研究员
3	张劲松	中科院金属研究所	研究员
4	徐 科	中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	主任/研究员
5	邓 涛	上海交通大学材料科学与工程学院	教授
6	段 炼	清华大学化学系	教授
7	吴 玲	国家半导体照明联盟	秘书长
8	闫晓林	TCL 集团股份有限公司	高级副总裁
9	郭太良	福州大学物理与信息工程学院	教授
10	孙 蓉	中科院先进技术研究院	研究员
11	赵振博	工业和信息化部电子五所电子材料研发部	副部长
12	张进成	西安电子科技大学科研院	院长/教授
13	张 凯	广东工业大学	教授